4E03

非断熱現象を利用した分子設計

(九大情基セ1・クイーズランド大2・京大福記セ3・分子研4) ○南部伸考¹, Hong Zhang², Sean C. Smith², 石田俊正³, 中村宏樹⁴

研究の背景と目的 非断熱遷移は分子機能を呼 び起こしさらに、制御するための鍵となる現象と考 えられる。我々はこれまで,周期的な非断熱トンネ ル型交差二準位ポテンシャルを持つ系に表れる 完全透過現象と完全反射現象を利用した分子ス イッチの可能性をモデルではあるが, 追求してき た. [1-4] さらに最近では、より現実的な系として カーボンナノチューブやフラーレンによる原子の カプセル化のモデルになりうる環状分子の水素原 子による環透過性に関する新たな提案を行ってい る. [5] 特に、コランニュレン及びコロネン分子を 用い、中心に存在する5員環及び6員環を透過さ せるために電子状態をどのように変えるかが鍵と なる.一般に、炭素面はかなり安定なため、ファン デルワールス力による小さな井戸が面の前には存 在するが、一様に反発型のポテンシャルとなる、そ こで,我々は活性を上げるため,ホウ素置換を提 案してきた、しかしながら、ホウ素置換の配置制御 が困難という意見もあることから、今回、フッ素原 子を付加する方法を試みた(図1および図2を参 照)結果を報告する.

計算方法 電子励起状態を正確に記述するため, 状態平均を取りながら多配置SCF(MCSCF)計算 を行い,分子軌道(MO)を決定した.次に,得られ た分子軌道を基に多配置参照配置間相互作用 計算(MRCI)を行い,電子基底状態及び励起状 図2:フッ素付加されたホウ素置換されたコ 態を求めた. 典型的なCI行列の大きさは約三千



図 1:フッ素付加させたコランニュレン分子



ロネン分子

万次元となり、かなり大きくなった、一方、CI計算において、非断熱トンネル確率を求める上で必要な 透熱化表現も同時に求めた.このようにして得られたポテンシャル曲線を基に量子動力学計算を行 い,水素原子の透過確率を求めた.また瞬間近似に従い、コランニュレン及びコロネン分子を固定し た上で水素原子の核の運動に関し三次元量子波束動力学計算を行うことにより透過確率を求めた。

結果と考察 図3にフッ素付加したコランニュレン分子の得られた分子軌道(HOMO, SOMO)の特徴 を示す. 87aと 88aがフッ素付加することによりコランニュレン分子中の5員環にシクロペンタジエニル



図 3: 水素原子とフッ素付加したコランニュレン分子の離れた位置(5Å)での分子軌道 ラジカルと類似のMOが局所的に得られていることが分かる.一方,89aが5員環の中心に向かう水素 原子の 1s軌道をしめす.特に以下の式(1)のように電子配置書くと、3 つのMOに 4 つの電子を詰め る問題となる.解離極限では87aと88aに 3 つ電子を詰まり、シクロペンタジエニルラジカルと

 \cdots [87a, 88a, 89a]⁴ (1)

類似の電子配置となり,89aに電子が1つ詰まった水素 原子を示す.

図 4 が5員環を透過する方向に描いたポテンシャル 曲線である. α の位置に擬交差が現れ,電子状態の 入れ替わりが起きていることがわかる. つまり, 89a 軌道 から 87a と 88a が作る半占有軌道へ, 1つ電子が移動 を起こし, 2つの2電子占有状態となり, ヒュッケル則 …[(87a)(88a)]³(89a)¹→…(87a)²(88a)²(89a)⁰

 (6π) を満たすことにより安定化する. つまり, それが β の位置に現れる極小となる. また, 有名なもり打ち 機構でもある.

図 5 が上記のモデルにおける水素原子透過確率 である.期待通り完全透過過程が得られ,4.0~ 5.0eVの入射エネルギー時において確率が1となる ピークが帯状に現れている.一方,その間に完全反 射現象によるディップも現れる.詳細は,講演で発 表する.

<u>参考文献</u> [1] Nakamura, *J. Chem. Phys.* **97**, 256 (1992); [2]Nanbu, Nakamura, Goodman, *J. Chem. Phys.* **107**, 5445 (1997); [3]Nakamura, *J. Chem. Phys.* **110**, 10253 (1999); [4] Nakamura, "Nonadiabatic Transition" World Scientific; [5] Nanbu, Ishida, Nakamura, *Chem. Phys.* **324**, 721–732 (2006).



